

D2SB□A

800V 2A

特長

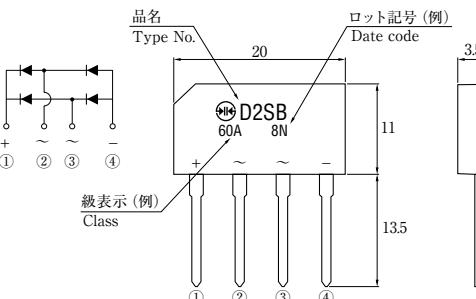
- ・薄型 SIP パッケージ
- ・高 Ifsm

Feature

- ・Thin-SIP
- ・Large Ifsm

■外観図 OUTLINE

Package : 2S

Unit : mm
Weight : 2g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

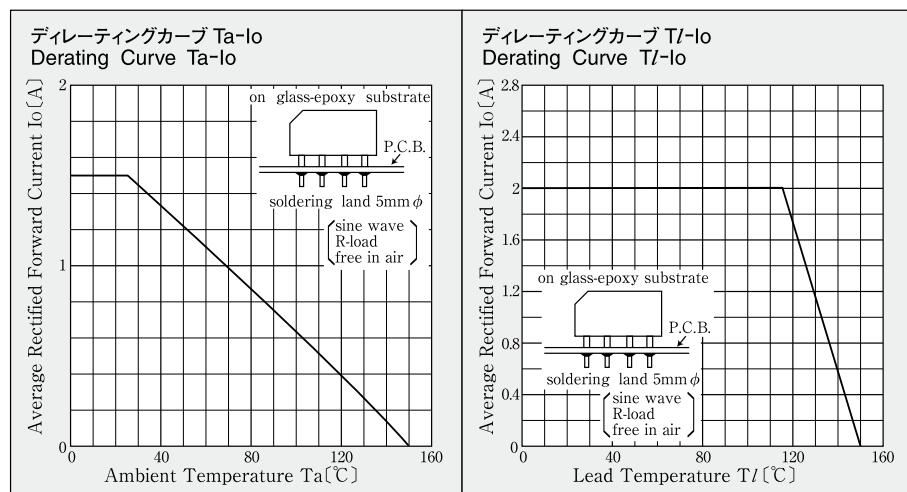
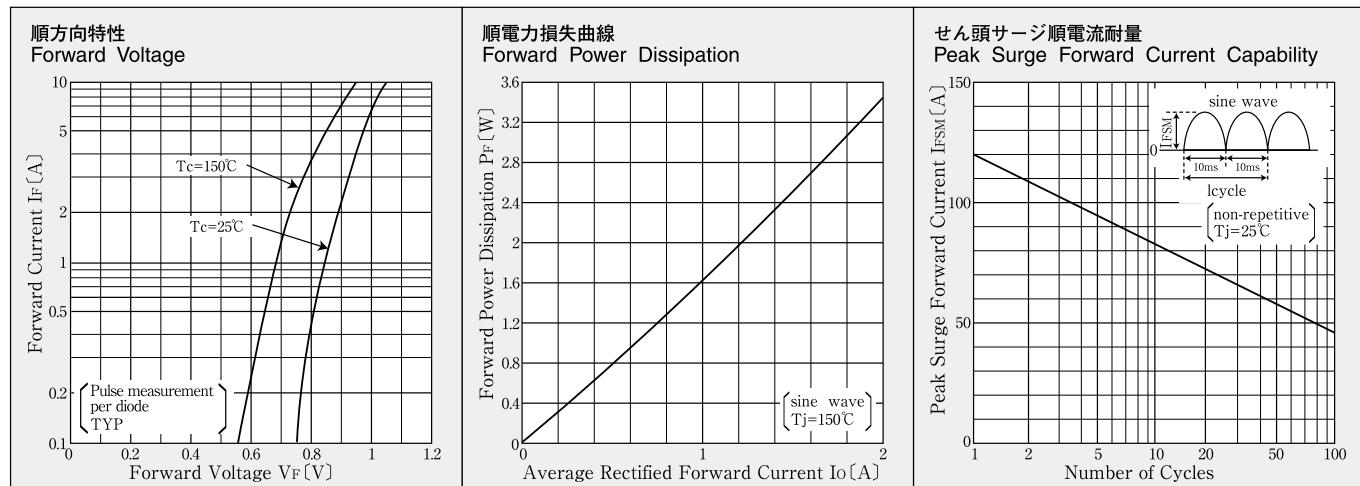
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $Tj = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D2SB60A	D2SB80A	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150		°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150		°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	Tj=115°C Ta=25°C	2	1.5	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, Tj=25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25°C		120		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms ≤ t < 10ms, Tj=25°C, 1 素子当たりの規格値 per diode		60		A ² s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $Tj = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	VF	If=1A, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 0.95	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=VRM, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θj/l	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 10	°C/W
	θja	接合部・周間間 Junction to Ambient	MAX 47	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9